

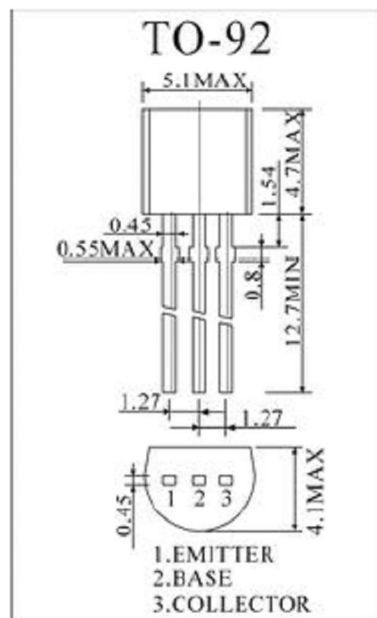
## TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

### C945

—NPN silicon—

#### ■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V <sub>CB0</sub>	60	V
集电极—发射极电压	V <sub>CEO</sub>	50	V
发射极—基极电压	V <sub>EB0</sub>	5	V
集电极电流	I <sub>c</sub>	0.15	A
集电极耗散功率	P <sub>c</sub>	0.4	W
结 温	T <sub>j</sub>	150	°C
存储温度	T <sub>stg</sub>	- 55~150	°C



#### ■电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	70	200	400		V <sub>CE</sub> = 6 V, I <sub>c</sub> = 1 mA
集电极-基极截止电流	I <sub>CB0</sub>			100	nA	V <sub>CB</sub> = 60 V, I <sub>E</sub> =0
发射极-基极截止电流	I <sub>EB0</sub>			100	nA	V <sub>EB</sub> = 5 V, I <sub>c</sub> =0
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	60			V	I <sub>c</sub> = 0.1 mA, I <sub>E</sub> =0
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	50			V	I <sub>c</sub> = 0.1 mA, I <sub>B</sub> =0
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EB0</sub>	5			V	I <sub>E</sub> = 0.1mA, I <sub>c</sub> =0
基极-发射极电压	V <sub>BE</sub>		0.62		V	V <sub>CE</sub> = 6 V, I <sub>c</sub> = 1mA
集电极-发射极饱和压降	V <sub>CE(sat)</sub>		0.15	0.3	V	I <sub>c</sub> = 100 mA, I <sub>B</sub> = 10 mA
基极-发射极饱和压降	V <sub>BE(sat)</sub>		0.86	1	V	I <sub>c</sub> = 100 mA, I <sub>B</sub> = 10 mA
电流增益-带宽乘积	f <sub>T</sub>	150	250	450	MHz	I <sub>c</sub> = 10 mA, V <sub>CE</sub> = 6 V
共基极输出电容	C <sub>ob</sub>		3.0	4.0	PF	V <sub>CB</sub> = 6 V, I <sub>E</sub> =0, f = 1 MHz
噪声系数	N <sub>F</sub>		8	15	dB	V <sub>CE</sub> =6V, I <sub>c</sub> =0.1mA, f=1KHz, R <sub>g</sub> =2K Ω

#### ■h<sub>FE</sub> 分档及其标志

分 档	O	Y	G
h <sub>FE</sub>	70~140	120~240	200~400